



行业动态  
Industry News



### 台积电将EUV列入光刻线路图

2008-05-12 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

日前,台积电(TSMC)在其2008年技术论坛会议上,简要描述了该公司光刻线路图(Lithography Roadmap),作为计划的一部分,TSMC对极紫外光刻技术进行了新的评估,并将其纳入光刻线路图。

目前,对于45纳米节点工艺的有限量产,TSMC采用193nm的浸没式光刻技术,光刻系统的数值孔径NA为1.2。TSMC表示,该光刻机来自其主要光刻合作伙伴ASML。

采用NA为1.35的193nm浸没式光刻机,配以双重图形技术,TSMC认为可以将晶圆工艺延伸至32nm节点,甚至可达22nm节点。该公司计划于2009年晚些时候进入32nm量产,而22nm暂定于2011年。

对于15nm或22nm技术节点,TSMC同时将EUV和无掩膜光刻技术纳入其线路图。几年前,TSMC已经对无掩膜光刻产生兴趣,并于最近从Mapper Lithography公司购入了相关设备。

但至少到目前为止,TSMC对于EUV光刻技术表现的相当冷淡。就像其他芯片制造商一样,该公司同样对EUV的绝对成本和技术障碍表示担心。该公司的光刻合作伙伴ASML希望,于2009年末发货一套试生产的EUV设备。

(来源:半导体国际 2008年4月25日)

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意